

# КТД8278 (А, А9, Б, Б9, В, В9) Мощный NPN кремниевый транзистор

**КТД 8278 - биполярный эпитаксиально-планарный транзистор Дарлингтона с защитным встроенным диодом.**

АДКБ.432140.165 ТУ

**Прибор предназначен для применения** в усилителях низкой частоты, стабилизаторах тока и напряжения, импульсных усилителях мощности, повторителях, переключающих устройствах, электронных системах управления защиты и автоматики, для коммутации тока в обмотке возбуждения генераторов переменного тока.

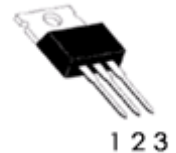
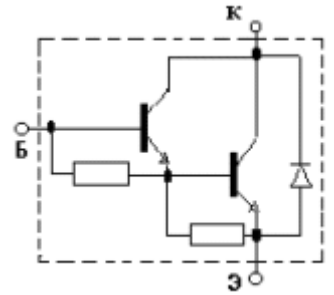
### Отличительные особенности:

сочетание низкого напряжения насыщения  $U_{кэ0нас}$  с высоким граничным напряжением  $U_{кэ0гр}$ ;

высокий коэффициент усиления  $h_{21э} > 1000$  на начальной стадии характеристики при токе коллектора  $I_k = 200mA$ .

**Аналоги: КТ827, КТ829АТ, КТ8116, КТД8246, КТД8253, SGSD93ST, SGSD93G, SGSD93F, SGSD93E.**

**Выпускается в двух корпусных исполнениях:** в пластмассовых корпусах ТО-220, ТО-263 и в бескорпусном исполнении- кристалл для использования в гибридных схемах.



ТО-220  
1 - база  
2 - коллектор  
3 - эмиттер



ТО-263  
1 - база  
2 - эмиттер

### Предельно-допустимые режимы эксплуатации.

Параметры	Обозначение	КТД8278 А,А9	КТД8278 Б,Б9	КТД8278 В,В9	Ед. измер.
Напряжение коллектор-база	$U_{кб0}$	200	180	160	В
Напряжение коллектор-эмиттер	$U_{кэ0}$	180	140	120	В
Напряжение эмиттер-база	$U_{эб0}$	4,5	4,5	4,5	В
Ток коллектора постоянный	$I_k$	20	20	20	А
Ток коллектора импульсный	$I_{ки}$	40	40	40	А
Ток базы постоянный	$I_б$	2	2	2	А
Рассеиваемая мощность коллектора	$P_{к max}$	75	75	75	Вт
Температура перехода	$T_j$	-65/+150	-65/+150	-65/+150	°С

**Основные электрические параметры ( $T_{\text{корп}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ ).**

Параметры	Обозначение	Норма	Режим	Группа	Ед. измер.
Обратный ток коллектор-эмиттер	$I_{кэо}$	$= < 50$	$U_{кэ} = 180\text{В}, R_{б} = \text{беск.}$	А, А9	мкА
			$U_{кэ} = 140\text{В}, R_{б} = \text{беск.}$	Б, Б9	
			$U_{кэ} = 140\text{В}, R_{б} = \text{беск.}$	В, В9	
Обратный ток коллектор-база	$I_{кбо}$	$= < 50$	$U_{кб} = U_{кэор} + 20\text{В}$	все	мкА
Обратный ток эмиттер-база	$I_{эбо}$	$= < 2$	$U_{эб} = 4\text{В}, I_{к} = 0$	все	мА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$U_{кэ.нас}$	$= < 1,4$	$I_{к} = 5\text{А}, I_{б} = 8\text{мА}$	все	В
Напряжение коллектор-эмиттер граничное	$U_{кэо гр}$	$= > 180$	$I_{к} = 100\text{мА}, I_{б} = 0$	А, А9	В
		$= > 140$		Б, Б9	
		$= > 120$		В, В9	
Напряжение насыщения база -эмиттер	$U_{бэ.нас}$	$= < 2,1$	$I_{к} = 5\text{А}, I_{б} = 8\text{мА}$	все	В
Статический коэффициент передачи тока	$h_{21э}$	$= > 1000$	$I_{к} = 0,2\text{А}, U_{кэ} = 1,5\text{В}$	все	-
		$= > 1000$	$I_{к} = 5\text{А}, U_{кэ} = 2,5\text{В}$		